



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11307563 A**(43) Date of publication of application: **05 . 11 . 99**

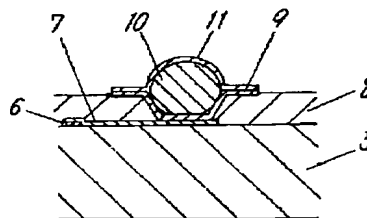
(51) Int. Cl.

H01L 21/60
H01L 21/60(21) Application number: **10107617**(22) Date of filing: **17 . 04 . 98**(71) Applicant: **MATSUSHITA ELECTRON CORP**(72) Inventor:
SAWARA RYUICHI
SHIMOISHIZAKA NOZOMI
NAKAMURA YOSHIFUMI
KUMAGAWA TAKAHIRO**(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS
MANUFACTURE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device, in which the thermal stresses caused by the mismatch between the coefficients of linear thermal expansion of a semiconductor element and a resin circuit board can be relieved by means of an insulating resin layer provided on the semiconductor element, and a method for manufacturing the device.

SOLUTION: Since a semiconductor device is provided with a metal wiring layer 7 which extends from a semiconductor element electrode 6 on a semiconductor element 5, an insulating resin layer 8 and a projecting electrode formed on the element 5 and wiring layer 7, the thermal stress applied to the projecting electrode due to the mismatch between the coefficients of linear thermal expansion of the semiconductor device and resin circuit board can be relieved.



COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-307563

(43)公開日 平成11年(1999)11月5日

(51)Int.Cl.⁶

H 0 1 L 21/60

識別記号

3 1 1

F I

H 0 1 L 21/92

21/60

21/92

6 0 2 L

3 1 1 Q

6 0 2 D

6 0 2 Z

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平10-107617

(22)出願日

平成10年(1998)4月17日

(71)出願人 000005843

松下電子工業株式会社

大阪府高槻市幸町1番1号

(72)発明者 佐原 隆一

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業株式会社内

(72)発明者 下石坂 望

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業株式会社内

(72)発明者 中村 嘉文

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

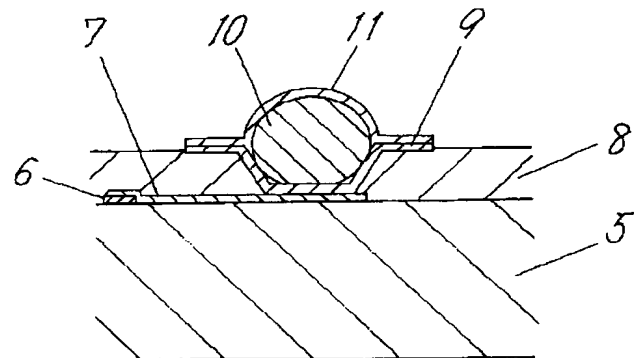
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 フリップチップ実装の半導体装置において、樹脂封止後、半導体素子の故障が発見された場合、封止樹脂と樹脂回路基板の密着が強固なため、リペアができないという課題があった。

【解決手段】 半導体素子5上の半導体素子電極6から延在した金属配線層7と、半導体素子5および金属配線層7上に形成された絶縁樹脂層8と、突起電極が形成された半導体装置であり、この構成により基板実装の際、半導体装置と樹脂回路基板との熱線膨張係数の不一致による突起電極部にかかる熱ストレスを緩和することができるものである。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層と、前記半導体素子および金属配線層上に形成された絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層表面と前記金属配線層を電気的に接続した金属層と、前記金属層上に形成された突起部材と、前記突起部材の表面と前記金属層とを電気的に接続する金属コートを備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 突起部材が金属ボールであることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】 突起部材が金属めっきであることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 4】 突起部材と絶縁樹脂層とが同一の低弾性率の樹脂よりなることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 5】 半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層と、前記金属配線層の一部を露出させ前記金属配線層上に形成され、表面に突起を有した絶縁樹脂層と、前記突起樹脂の表面と前記絶縁樹脂層から露出した金属配線層を電気的に接続する金属層を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】 半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層を形成する工程と、前記半導体素子および前記金属配線層上に絶縁樹脂層を形成する工程と、前記絶縁樹脂層に開口部を形成し、前記金属配線層の一部を露出させる工程と、前記露出した金属配線層と前記絶縁樹脂層表面とを接続する金属層を形成する工程と、前記開口部上に突起樹脂を形成する工程と、前記突起樹脂の表面と前記金属層を電気的に接続する金属コートを形成する工程とよりなることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 7】 突起樹脂を形成する工程は、開口部を形成した半導体素子全面に感光性樹脂を塗布し、写真法で突起樹脂を形成する工程であることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 8】 突起樹脂を形成する工程は、開口部を形成した半導体素子全面に絶縁樹脂を塗布し、サンドブラスト法で突起樹脂を形成する工程であることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 9】 突起樹脂を形成する工程は、開口部を形成した半導体素子全面に絶縁樹脂を塗布し、エッチング法で突起樹脂を形成する工程であることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 10】 突起樹脂を形成する工程は、はんだペーストあるいはフラックスを開口部に供給し、はんだボールを搭載、溶融することで金属突起電極を形成する工程であることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 11】 半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層を形成する工程と、前記半導体素

子および前記金属配線層上に感光性絶縁樹脂を塗布し、写真法により突起樹脂を形成する工程と、写真法を繰り返し前記絶縁樹脂層に前記金属配線層に達する開口部を形成する工程と、前記金属配線層と前記突起樹脂とを接続する金属層を形成する工程とよりなることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 12】 突起電極および開口部をサンドブラスト法にて形成することを特徴とする請求項 11 に記載の半導体装置の製造方法。

10 【請求項 13】 突起電極および開口部をエッチング法にて形成することを特徴とする請求項 11 に記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の集積回路部を保護し、かつ外部装置と半導体素子の電気的な接続を確保し、さらにもっとも高密度な実装を可能とした半導体装置およびその製造方法に関するものである。そして本発明の半導体装置により、情報通信機器、事務用電子機器等の小型化を容易にするものである。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体装置及びその製造方法は電子機器の小型化、高機能化に伴い、小型化、高密度化、高速化を要求されるようになり、たとえば C4 (Controlled Collapse Chip Connection) といったいわゆるフリップチップボンディングを用いた実装技術が開発されている。

20 【0003】以下、従来の C4 と呼ばれる半導体装置およびその製造方法について断面図を参照しながら説明する。

【0004】図 4 は、従来の C4 と呼ばれる実装技術を用いた半導体装置の断面図である。図 4 において、1 は半導体素子、2 は半導体素子電極、3 は金属層、4 は突起電極である。

【0005】図 4 に示すように、従来の半導体装置は、半導体素子 1 上の半導体素子電極 2 上に金属層 3 が形成され、前記金属層上に突起電極 4 が形成された構造である。

40 【0006】次に従来の半導体装置の製造方法について、同様に図 4 の断面図を参照しながら説明する。

【0007】まず複数の半導体素子 1 が半導体ウエハ（図示せず）上に形成され、個々の半導体素子 1 上には複数の半導体素子電極 2 が形成されている。そしてスパッタリング法により半導体ウエハ全面に金属層 3 を形成する。次にめっきレジストを塗布し、写真法により半導体素子電極 2 に相当する位置を開口する。次に電解めっき法により Sn（錫）、Pb（鉛）といった金属を開口位置の金属層 3 上に形成する。めっきレジストを除去後、めっき金属をレジストとして金属層 3 をエッチングにより除去する。次に半導体ウエハ全面にフラックスを

塗布し、リフローすることにより、突起電極4を形成する。

【0008】以上のような工法により従来の半導体装置が製造されるものである。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら前記従来の半導体装置では、半導体装置を樹脂回路基板に搭載する場合、突起電極部に対して、樹脂回路基板と半導体装置との熱線膨張係数の不一致による熱ストレスが発生するため、樹脂回路基板と半導体装置との間隙に封止樹脂を注入し、突起電極部にかかる熱ストレスを緩和しなければならなかった。この場合、半導体装置と樹脂回路基板との間隙が狭く、封止樹脂の注入が非常に困難であり、また個々の半導体素子を個別に封止するため、生産性が悪いという課題を有していた。さらに樹脂封止後、半導体装置の故障、不良が発見された場合、封止樹脂と樹脂回路基板との密着が強固なため故障、不良のあった半導体装置を樹脂回路基板から取り外すのは困難であり、仮に取り外せた場合であっても樹脂回路基板を損傷させてしまうため、その樹脂回路基板への半導体装置の再搭載は不可能であり、生産性、生産コスト上の課題があった。

【0010】本発明は前記従来の課題を解決するもので、半導体装置の生産性に着目し、またリペアを可能として、半導体素子上に絶縁樹脂層を設けることで半導体素子と樹脂回路基板の熱線膨張係数の不一致による熱ストレスを緩和できる半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために、本発明の半導体装置は、半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層と、前記半導体素子および金属配線層上に形成された絶縁樹脂層と、前記絶縁樹脂層表面と前記金属配線層を電気的に接続した金属層と、前記金属層上に形成された突起部材と、前記突起部材の表面と前記金属層とを電気的に接続する金属コートを備えた半導体装置である。また、突起部材が金属ボールである半導体装置である。また、突起部材が金属めっきである半導体装置である。また、突起部材と絶縁樹脂層とが同一の低弾性率の樹脂よりなる半導体装置である。

【0012】さらに本発明は、半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層と、前記金属配線層の一部を露出させ前記金属配線層上に形成され、表面に突起を有した絶縁樹脂層と、前記突起樹脂の表面と前記絶縁樹脂層から露出した金属配線層を電気的に接続する金属層を備えた半導体装置である。

【0013】製造方法においては、半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層を形成する工程と、前記半導体素子および前記金属配線層上に絶縁樹脂

層を形成する工程と、前記絶縁樹脂層に開口部を形成し、前記金属配線層の一部を露出させる工程と、前記露出した金属配線層と前記絶縁樹脂層表面とを接続する金属層を形成する工程と、前記開口部に突起樹脂を形成する工程と、前記突起樹脂の表面と前記金属層を電気的に接続する金属コートを形成する工程とよりなる半導体装置の製造方法である。また、突起樹脂を形成する工程は、開口部を形成した半導体素子全面に感光性樹脂を塗布し、写真法で突起樹脂を形成する工程である。また、突起樹脂を形成する工程は、開口部を形成した半導体素子全面に絶縁樹脂を塗布し、サンドブラスト法で突起樹脂を形成する工程である。また、突起樹脂を形成する工程は、開口部を形成した半導体素子全面に絶縁樹脂を塗布し、エッチング法で突起樹脂を形成する工程である。また、突起樹脂を形成する工程は、はんだペーストあるいはフラックスを開口部に供給し、はんだボールを搭載、熔融することで金属突起電極を形成する工程である。

【0014】また本発明の半導体装置の製造方法は、半導体素子と前記半導体素子の電極から延在した金属配線層を形成する工程と、前記半導体素子および前記金属配線層上に感光性絶縁樹脂を塗布し、写真法により突起樹脂を形成する工程と、写真法を繰り返し前記絶縁樹脂層に前記金属配線層に達する開口部を形成する工程と、前記金属配線層と前記突起樹脂とを接続する金属層を形成する工程とよりなる半導体装置の製造方法である。また、突起電極および開口部をサンドブラスト法にて形成する半導体装置の製造方法である。また、突起電極および開口部をエッチング法にて形成する半導体装置の製造方法である。

【0015】前記構成により、本発明の半導体装置は、低弾性率の絶縁樹脂層を設けているので、半導体装置を樹脂回路基板に搭載する場合、半導体装置と樹脂回路基板の熱線膨張係数の不一致による突起電極部にかかる熱ストレスを緩和することができる。そのため、従来のように半導体装置を樹脂回路基板に搭載後、封止樹脂注入工程が不要である。また、従来のように封止樹脂を用いていないので、半導体装置に欠陥、不良が発見された場合には、加熱処理することで、接続部はんだを熔融し、容易に樹脂回路基板から半導体装置を取り外すことができるため、生産性、生産コスト的にも有利である。

【0016】また低弾性率材料により樹脂突起を形成し、突起電極を構成しているため、半導体装置を樹脂回路基板に搭載する場合、半導体装置と樹脂回路基板の熱線膨張係数の不一致による突起電極部にかかる熱ストレスを緩和することができ、基板実装の信頼性を向上させることができる。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。

【0018】図1は本発明の第1の実施形態における半導体装置を示す断面図である。図1に示すように本実施形態の半導体装置は、半導体素子5上には、半導体素子5上の半導体素子電極6から延在した金属配線層7が設けられ、その半導体素子5上に絶縁樹脂層8が設けられ、絶縁樹脂層8の表面と金属配線層7とを電氣的に接続する金属層9が設けられている。そして、その金属層9上に突起部材として突起樹脂10が設けられ、その突起樹脂10と金属層9とを電氣的に接続する金属コート11が形成されているものである。

【0019】すなわち、本実施形態の半導体装置では、半導体素子5上の半導体素子電極6から外部接続のために、金属配線層7、金属層9により配線の引き直しを行なうとともに、絶縁樹脂層8により半導体素子電極6、金属配線層7を保護している。そして突起電極を構成するために、金属層9上に突起樹脂10を形成して、その表面および下地の金属層9上に金属コート11を形成して、実質的に突起樹脂に導電性を持たせ、突起電極（外部電極）を構成しているものである。

【0020】また本実施形態の半導体装置において、突起樹脂10が設けられた絶縁樹脂層8の開口部の断面形状は、その表面に形成される金属層9の形成、および形成した後の金属層の信頼性、また半導体装置として基板実装する際、半導体装置の外部電極と基板との接続の信頼性を考慮して、断面形状ではテーパー状をなして形成されているものである。

【0021】本実施形態において半導体素子電極6から延在した金属配線層7としては、Ti（チタン）を密着金属、Cu（銅）を導体金属として用いた2層構造を有している。なお、金属材料としてはTi（チタン）、Cr（クロム）、TiW（チタン・タングステン）、Cu（銅）、Ni（ニッケル）、Au（金）、Pd（パラジウム）、Ag（銀）などを用いても構わないし、それぞれの金属の組み合わせでも構わない。

【0022】以上のように構成された半導体装置について、以下、その製造方法について図2を参照しながら説明する。

【0023】まず図2（a）には、個々の半導体素子が形成された半導体ウエハ12を示しており、半導体素子電極6が形成されている。

【0024】次に図2（b）に示すように、真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、無電解めっき法あるいは電解めっき法により半導体ウエハ12上全面に金属層を形成し、エッチングレジストをマスクとして金属層をエッチングすることで半導体素子電極6から延在した金属配線層7を形成する。ここで金属配線層7の一例としては、Ti（チタン）を密着金属、Cu（銅）を導体金属とした2層構造を用いた。また金属材料としてはTi（チタン）、Cr（クロム）、TiW（チタン・タングステン）、Cu（銅）、Ni（ニッケル）、Au

（金）、Pd（パラジウム）、Ag（銀）などを用いても構わないし、それぞれの金属の組み合わせでも構わない。

【0025】次に図2（c）に示すように、金属配線層7の一部を露出させ、かつ露出部分（開口部）の形状がテーパー状になるように絶縁樹脂層8を形成する。本実施形態では絶縁樹脂層8の形成の一例として、感光性ポリイミドを用い、写真法を用いて絶縁樹脂層8をパターニングして金属配線層7の一部を露出させた。また絶縁樹脂層8の絶縁材料としては、エポキシ樹脂などを用いても構わないが低弾性率（3000kg/mm²以下）であることが望ましいが、突起電極部にかかる熱ストレスを緩和することができる範囲の弾性率を有していればよい。また、形成方法としては、エッチング法、サンドブラスト法、プラズマ法などを用いて金属配線層7の一部を露出しても構わない。なお絶縁樹脂層8の厚みは、その目的から10[μm]以上であることが望ましい。

【0026】次に図2（d）に示すように、真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、無電解めっき法、あるいは電解めっき法により半導体ウエハ12上全面に金属層を形成し、エッチングレジストをマスクとして金属層をエッチングすることで、絶縁樹脂層8表面と金属配線層7を電氣的に接続する金属層9を形成する。ここで金属層9の一例としては、Ti（チタン）を密着金属、Cu（銅）を導体金属とした2層構造を用いた。また金属材料としてはTi（チタン）、Cr（クロム）、TiW（チタン・タングステン）、Cu（銅）、Ni（ニッケル）、Au（金）、Pd（パラジウム）、Ag（銀）などを用いても構わないし、それぞれの金属の組み合わせでも構わない。また、絶縁樹脂の開口部、すなわち下地の金属配線層7の露出している部分の絶縁樹脂層8の形状をテーパー状に形成しているので、均一な厚みで金属層9を形成することができる。

【0027】次に図2（e）に示すように、絶縁樹脂層8の開口部の金属層9上に印刷法により突起樹脂10を形成する。ここで突起部材である突起樹脂10の一例としては、ポリイミド樹脂を用いた。また突起樹脂10の材料としてはエポキシ樹脂などを用いても構わないし、エッチング法、サンドブラスト法、プラズマ法などを用いて突起樹脂10を形成しても構わない。なお、突起樹脂10の形成位置は、必ずしも絶縁樹脂層8の開口部である必要はなく、金属層9上であればよい。

【0028】次に図2（f）に示すように、真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、無電解めっき法、あるいは電解めっき法により半導体ウエハ12上全面に金属層を形成し、エッチングレジストをマスクとして金属層をエッチングすることで、突起樹脂10表面と金属層9を電氣的に接続する金属コート11を部分的に形成する。金属コート11の形成は、突起樹脂10を外部電極とするためのものであり、金属層9、金属配線層7を介

して半導体素子電極6と電氣的に接続するものである。ここで金属コート11の一例としては、Ti(チタン)を密着金属、Cu(銅)を導体金属とした2層構造を用いた。また金属材料としてはTi(チタン)、Cr(クロム)、TiW(チタン・タングステン)、Cu(銅)、Ni(ニッケル)、Au(金)、Pd(パラジウム)、Ag(銀)などを用いても構わないし、それぞれの金属の組み合わせでも構わない。また、本実施形態は、突起電極を構成する部材として、突起樹脂10を用いたが突起樹脂のかわりにそれ自体が導電性を有した金属ボールを用いても構わないし、金属めっきによる突起形成でも構わない。

【0029】次に図2(g)に示すように、半導体ウエハ12の個々の半導体素子の分割として、半導体ウエハ12に形成されたスクライブライン(図示せず)に沿って、ダイシングソーにより個々の半導体素子に分割する。分割することにより、図1に示したような、半導体素子5上の半導体素子電極6から延在した金属配線層7が設けられ、その金属配線層7上に絶縁樹脂層8と、金属配線層7と絶縁樹脂層8の表面と電氣的に接続した金属層9が設けられ、絶縁樹脂層8の開口部に突起樹脂10が形成され、突起樹脂10の表面と、金属層9とが電氣的に接続した金属コート11が形成された半導体装置が形成される。

【0030】本実施形態では、低弾性率の絶縁樹脂層8を設けてあるので、半導体装置を樹脂回路基板に搭載する場合、半導体装置と樹脂回路基板との熱線膨張係数の不一致による突起電極部(突起樹脂10+金属コート11)にかかる熱ストレスを緩和することができるため、従来のように半導体装置を樹脂回路基板に搭載後、封止樹脂注入工程が不要である。また、封止樹脂を用いていないので、基板実装した半導体装置に欠陥、不良が発見された場合には、加熱処理することで、接続部はんだを溶融し、容易に樹脂回路基板から半導体装置を取り外すことができるため、生産性、生産コスト的にも有利である。

【0031】次に本発明の第2の実施形態について図面を参照しながら説明する。図3は本実施形態における半導体装置を示す断面図である。図3に示すように本実施形態の半導体装置は、半導体素子13上の半導体素子電極14から延在した金属配線層15が設けられ、その半導体素子上に突起構造を有した絶縁樹脂層16が設けられ、絶縁樹脂層16の突起部16aと金属配線層15とを電氣的に接続する金属層17が形成されているものである。また、絶縁樹脂層16により構成される突起部16aの形状は、その表面に形成される金属層17の形成、および形成した後の金属層17の信頼性、また半導体装置として基板実装する際、半導体装置の外部電極と基板との接続の信頼性を考慮して、断面形状ではテーパ状をなして形成されているものである。

【0032】以上のように構成された半導体装置について以下、その製造方法について説明する。

【0033】前記した第1の実施形態と同様に、半導体ウエハ全面に真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、無電解めっき法あるいは電解めっき法により半導体ウエハ上全面に金属層を形成し、エッチングレジストをマスクとして金属層をエッチングすることで半導体素子電極14から延在した金属配線層15を形成する。ここで金属配線層15の一例としては、Ti(チタン)を密着金属、Cu(銅)を導体金属とした2層構造を用いた。また金属材料としてはTi(チタン)、Cr(クロム)、TiW(チタン・タングステン)、Cu(銅)、Ni(ニッケル)、Au(金)、Pd(パラジウム)、Ag(銀)などを用いても構わないし、それぞれの金属の組み合わせでも構わない。

【0034】次に金属配線層15の一部が露出し、かつ突起部16aを設けた絶縁樹脂層16を形成する。本実施形態では絶縁樹脂層16の形成として、感光性ポリイミドを用い、写真法を用いて突起部16aを形成し、再び写真法を繰り返し、金属配線層15の一部を露出させた。また絶縁樹脂層16を構成する材料としては、エポキシ樹脂などを用いても構わないが、低弾性率(1000kg/mm²以下)であることが望ましい。形成方法としては、エッチング法、サンドブラスト法、プラズマ法などを用いて突起部16aおよび金属配線層15の一部を露出しても構わない。なお絶縁樹脂層16の厚みは、10[μm]以上であるほうが望ましい。次に半導体ウエハ全面に真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、無電解めっき法あるいは電解めっき法により半導体ウエハ上全面に金属層を形成し、エッチングレジストをマスクとして金属層をエッチングすることで半導体素子電極14から絶縁樹脂層16の突起部16aまで延在した金属配線層15を形成する。ここで金属配線層15の一例としては、Ti(チタン)を密着金属、Cu(銅)を導体金属とした2層構造を用いた。また金属材料としてはTi(チタン)、Cr(クロム)、TiW(チタン・タングステン)、Cu(銅)、Ni(ニッケル)、Au(金)、Pd(パラジウム)、Ag(銀)などを用いても構わないし、それぞれの金属の組み合わせでも構わない。

【0035】次に半導体ウエハの個々の半導体素子の分割として、半導体ウエハに形成されたスクライブラインに沿ってダイシングソーにより半導体素子を個々に分割し、半導体素子13上の半導体素子電極14から延在した金属配線層15が設けられ、その金属配線層15上の突起部を備えた絶縁樹脂層16と、金属配線層15から絶縁樹脂層16の突起部まで延在する金属層17が形成された半導体装置が形成される。

【0036】以上、本発明の実施形態で示した半導体装置において、第1の実施形態では、絶縁樹脂層8を設け

ているので、半導体装置を樹脂回路基板に搭載した場合、半導体装置と樹脂回路基板との熱線膨張係数の不一致による突起電極部（突起樹脂 1 0 + 金属コート 1 1）にかかる熱ストレスを緩和することができ、基板実装の接続の信頼性を向上させることができる。第 2 の実施形態では、突起電極自体が絶縁樹脂により構成された突起部よりなるため、半導体装置を樹脂回路基板に搭載した場合、半導体装置と樹脂回路基板との熱線膨張係数の不一致による突起電極部（突起部 1 6 a + 金属層 1 7）にかかる熱ストレスを緩和することができ、基板実装の接続の信頼性を向上させることができる。

【0037】また、第 1 の実施形態と第 2 の実施形態とにおいて、突起電極の構成は、突起樹脂を別形成したものと、突起樹脂を絶縁樹脂により一体形成したものととの構造上、製造工法上の違いはあるが、その狙いとするところは、低弾性率の絶縁樹脂層を設け、半導体装置を樹脂回路基板に搭載する場合、半導体装置と樹脂回路基板との熱線膨張係数の不一致による突起電極部にかかる熱ストレスを緩和することができるものである。

【0038】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明では、低弾性率の絶縁樹脂層を設けているので、半導体装置を樹脂回路基板に搭載する場合、半導体装置と樹脂回路基板との熱線膨張係数の不一致による突起電極部にかかる熱ストレスを緩和することができる。そのため、従来のように半導体装置を樹脂回路基板に搭載後、封止樹脂注入工程が不要である。また、封止樹脂を用いていないので、半導体素子に欠陥、不良が発見された場合には、加熱処理することで、接続部はんだを溶融し、容易に樹脂*

* 回路基板から半導体素子を取り外すことができるため、生産性、生産コスト的にも有利である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施形態における半導体装置を示す断面図

【図 2】本発明の一実施形態における半導体装置の製造方法を示す断面図

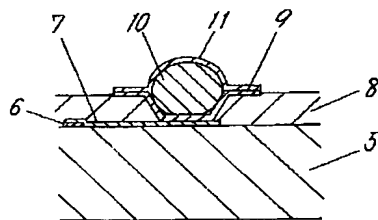
【図 3】本発明の一実施形態にかかる半導体装置を示す断面図

10 【図 4】従来の半導体装置を示す断面図

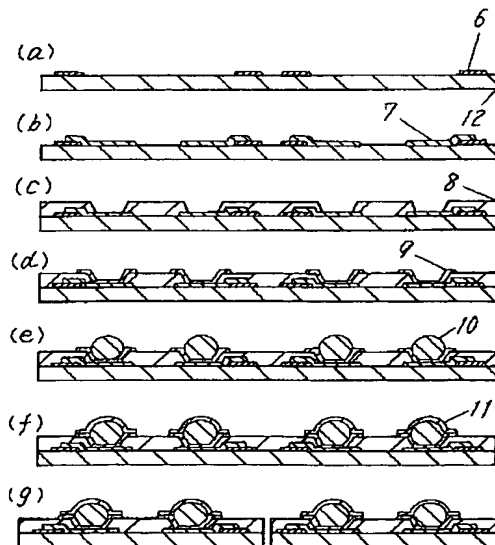
【符号の説明】

- 1 半導体素子
- 2 半導体素子電極
- 3 金属層
- 4 突起電極
- 5 半導体素子
- 6 半導体素子電極
- 7 金属配線層
- 8 絶縁樹脂層
- 20 9 金属層
- 10 突起樹脂
- 11 金属コート
- 12 半導体ウエハ
- 13 半導体素子
- 14 半導体素子電極
- 15 金属配線層
- 16 絶縁樹脂層
- 16 a 突起部
- 17 金属層

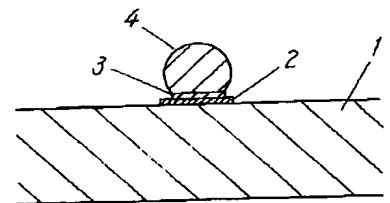
【図 1】



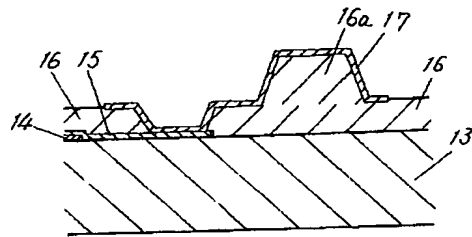
【図 2】



【図 4】



【図 3】



フロントページの続き

(72)発明者 隈川 隆博
大阪府高槻市幸町 1 番 1 号 松下電子工業
株式会社内